

2SK891

シリコンNチャンネルMOS形電界効果トランジスタ (π -MOSII)

通信工業用
単位：mm

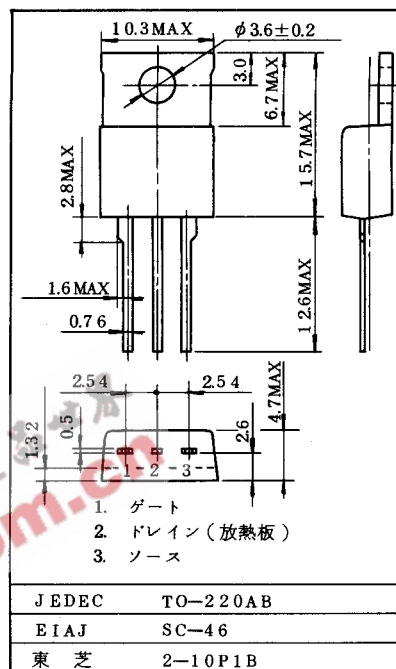
- 高速、大電流スイッチング用
- スwitchングレギュレータ、DC-DCコンバータ用
- モータドライブ用

- ・ オン抵抗が低い : $R_{DS(ON)} = 0.14\Omega$ (標準)
- ・ 順方向伝達アドミタンスが高い : $|Y_{fs}| = 9.0S$ (標準)
- ・ 漏れ電流が低い : $I_{DSS} = 300\mu A$ (最大) ($V_{DS} = 200V$)
- ・ 取扱いが簡単な、エンハンスメントタイプです。

: $V_{th} = 1.5 \sim 3.5 V$ ($V_{DS} = 10V, I_D = 1mA$)

最大定格 ($T_a = 25^\circ C$)

項目	記号	定格	単位
ドレイン・ソース間電圧	V_{DSS}	200	V
ドレイン・ゲート間電圧 ($R_{GS} = 20k\Omega$)	V_{DGR}	200	V
ゲート・ソース間電圧	V_{GSS}	± 20	V
ドレイン電流	DC	I_D	20
	パルス	I_{DP}	80
許容損失 ($T_c = 25^\circ C$)	P_D	125	W
チャンネル温度	T_{ch}	150	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	$-55 \sim 150$	$^\circ C$



熱抵抗特性

項目	記号	最大	単位
チャンネル・ケース間熱抵抗	$R_{th(ch-c)}$	1.0	$^\circ C/W$
チャンネル・外気間熱抵抗	$R_{th(ch-a)}$	83.3	$^\circ C/W$

この製品はMOS構造ですので取扱いの際には静電気にご注意ください。

電気的特性 (Ta = 25°C)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
ゲート漏れ電流	I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 20V, V_{DS} = 0V$	—	—	± 100	nA
ドレインシャ断電流	I_{DSS}	$V_{DS} = 200V, V_{GS} = 0V$	—	—	300	μA
ドレイン・ソース間降伏電圧	$V_{(BR)DSS}$	$I_D = 10mA, V_{GS} = 0V$	200	—	—	V
ゲートしきい値電圧	V_{th}	$V_{DS} = 10V, I_D = 1mA$	1.5	—	35	V
ドレイン・ソース間オン抵抗	$R_{DS(ON)}$	$I_D = 10A, V_{GS} = 10V$	—	0.14	0.18	Ω
順方向伝達アドミタンス	$ Y_{fs} $	$V_{DS} = 10V, I_D = 10A$	6.0	9.0	—	S
入力容量	C_{iss}	$V_{DS} = 10V, V_{GS} = 10V, I_D = 20A$	—	1200	1600	pF
帰還容量	C_{rss}		—	230	300	
出力容量	C_{oss}		—	580	750	
スイッチング時間	上昇時間	t_r		30	60	ns
	ターンオン時間	t_{on}		45	90	
	下降時間	t_f		30	60	
	ターンオフ時間	t_{off}		70	140	
ゲート入力電荷量	Q_g	$V_{DD} = 160V, V_{GS} = 10V, I_D = 20A$	—	43	60	nC
ゲート・ソース間電荷量	Q_{gs}		—	16	—	
ゲート・ドレイン間電荷量	Q_{gd}		—	27	—	

ソース・ドレイン間ダイオードの定格と特性 (Ta = 25°C)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
ドレイン逆電流(連続)	I_{DR}	—	—	—	20	A
ドレイン逆電流(パルス)	I_{DRP}	—	—	—	80	A
順方向電圧	V_{DSF}	$I_{DR} = 20A, V_{GS} = 0V$	—	—	-20	V
逆回復時間	t_{rr}	$I_{DR} = 20A, V_{GS} = 0V$	—	650	—	ns
逆回復電荷量	Q_{rr}	$dI_{DR}/dt = 50A/\mu s$	—	4.1	—	μC